P22

外部共振器半導体レーザによる フラッシュランプ励起 Ti:サファイアレーザの波長制御特性

Characteristics of a flashlamp pumped Ti:sapphire laser seeded by an external cavity laser diode 京光 達哉 長澤 親生 阿保 真 T.Kyomitsu, C.Nagasawa and M.Abo 東京都立大学 工学部 Tokyo Metropolitan University

Abstract : Single mode operation of a flashlamp pumped Ti:sapphire laser controlled by injectionseeding technique is reported. The injection laser consists of an external cavity laser diode (ECLD). The laser diode without anti-reflection coating is commercially available. The linewidth(FWHM) of an ECLD with an output power of 12mW is about 0.3pm, and the linewidth(FWHM) of a flashlamp pumped Ti:sapphire laser injection-seeded by the ECLD is about 1.2pm .

1. はじめに

Ti:sapphire レーザはその発振波長が 700nm から 1000nm までの広範囲にわたる可変波長域を持つ 固体レーザである。従来のパルス Ti:sapphire レーザは主に Nd:YAG レーザの第 2 高調波で励起する ものが多く、高出力を得るためにはアンプ段を設ける必要があるため調整が複雑になっている。同じ近 赤外領域の高出力可変波長レーザとして、フラッシュランプ励起アレキサンドライトレーザがあるが、 Ti:sapphire レーザと比べて可変波長域が狭く (720~800 nm)、レーザロッドを暖める必要がある等 の問題点がある。これに対し、蛍光コンバータによるランプ発光スペクトルの conversion、 cw-simmer とプリパルス技術を用いたフラッシュランプ励起 Ti:sapphire レーザは、高効率のパルス発振が可能で ある^[1]。

Ti:sapphireレーザの発振波長域には水蒸気の吸収線が多数存在し、水蒸気DIALの高精度測定が可能 である。また、中間圏の金属元素の共鳴散乱観測では、基本波によりカリウム(770nm),第2高調波に よりFe(372nm),Caイオン(397nm)等の測定が可能である。しかし、これらの測定をする場合、単 ーの縦モードを選択することが必要となる。単一モードの選択法として、エタロン・複屈折フィルタな どの光学素子を挿入し、必要となる縦モード以外の損失を増やしたり分散させる方法と、外部から単一 周波数のレーザを入射し共振器の特定の縦モードを誘導放出させ、他のモードの発振を抑制するインジ ェクションシーディングと呼ばれる方法がある。インジェクションシーディングは光学素子を挿入する 方法と比べて共振器の内部損失が少ないという利点がある。そこで我々は、外部共振器型LDと呼ばれる LDの外部に共振器を加えたCW狭帯域レーザを試作し、このレーザによるフラッシュランプ励起Ti:sapphireレーザへのインジェクションシーディングの実験を行った。

2. 外部共振器型半導体レーザ

外部共振器型LDはLD単体と比ベライン幅が狭く^[2]、またモードホップを抑制することが出来るという シーダ光として最適な特性を持つ。今回の実験で用いた外部共振器はFig.1に示すように、透過型回折 格子とピエゾ素子により角度調整可能なミラーを用いたものである。LD単体では、Fig.2のように温度 ・電流制御によりある程度の波長可変が可能である。しかし、Fig.2からもわかるように、波長よってホ ップする領域が存在する。また、その波長可変領域も数nmと狭い領域にとどまる。これに対して、一般 的に外部共振器型LDは連続波長可変であることが知られている^[3]。これは、外部共振器型LDに使用さ れるLDの端面にARコート(非反射膜)を施すことにより可能となる。今回使用したLDは市販のものであ り、LDの端面にはARコートが施されていない。Fig.3に市販のLDを使用した外部共振器型LDのチューニ ング特性を示す。市販のLDを使用する場合、波長の可変領域を広くすることはできるが、連続可変とは ならない。これは、LD内部の共振器長で決まる波長でのみ共振状態を保つことができるためである。







≣[°c]



Fig.3 Wavelength-power tuning profile of the ECLD (LD:HITACHI HL7851G)









Fig.5 Experimental setup of the injection seeding Ti:sapphire laser by using the ECLD.

しかし、外部共振器のPZTミラーの制御とLDの電流・温度の調節を併用することにより、目的の波長で 発振させることが可能となる。LDの温度・電流調節は、LDの活性領域の屈折率を変化させることであり 実質的な内部共振器長の変化に相当する。また、そのスペクトルも、LD単体のものと同等の値を得るこ とが可能である。

今回使用したLDは出力40mWのHITACHI製IL7851Gである。このLDを使用した外部共振器LDにより得られ た発振波長域は、Fig.3に示したように温度10℃で約779nm~788nmであり、出力は約18mWであった。ま たライン幅はどの波長においても半値幅で約0.3pmであった。Fig.4にスキャニングエタロンによるスペ クトルの測定例を示す。

3. インジェクションシーディングの実験

Fig.5に外部共振器型LDによるフラッシュランプ励起Ti:sapphireレーザのインジェクションシーディ ング実験のシステム図を示す。外部共振器型LDから出た光をアイソレータ(アイソレーション30dB)を通 して光ファイバに入れる。このアイソレータは、光ファイバの端面反射による半導体レーザへの戻り光 をカットするためのものである。そして、光ファイバから出た光をレンズを用いて集光し、アイソレー タを介してTi:sapphireレーザに注入する。ここで、Ti:sapphireレーザ側のアイソレータ(アイソレー ション 30dB)はTi:sapphireレーザからのパルス光がLDに戻るのを防ぐものである。今回の実験では Ti:sapphireレーザの出力が約30mJと小さいため、この位置のアイソレータは1個で十分である。

Fig.6は、インジェクションシーディングをかけた場合とかけない場合のFSR4.8pmのファブリーペ ローエタロンによるフリンジパターンである。(発振波長783.88nm)シーディングをかけない場合、 Ti:sapphireレーザは多モードで発振するが、シーディングをかけた場合、Ti:sapphireレーザのライン 幅(FWHM)が約1.2pmという値で発振が可能であることがわかる。

Fig.7にカリウムのレーザのライン幅に対する共鳴散乱断面積の特性を示す。インジェクションシー ディングをかけた場合のTi:sapphireレーザのライン幅(1.2pm)は、共鳴散乱ライダーのシステムとし て実際に使用する場合の効率から考えると許容範囲の値であることがわかる。しかし、Ti:sapphireレ ーザの時間幅(50ns)で決まるライン幅がシーダ光のライン幅(0.3pm)より十分に小さいことから、原 理的にはシーダ光と同等のライン幅まで狭帯域化が可能である。



Fig.6 Fabry-Perot interference fringe pattern of a flashlamp pumped Ti:sapphire laser (a) without injection seeding,(b) with injection seeding



Fig.7 Linewitdh-effective resonance scattering cross section property (Potassium:Resonance scattering wavelength 769.898nm)

4. 今後の課題

本システムをライダーの発振器として利用する場合には、波長・スペクトルを長時間にわたって安定 させる必要がある。しかし今回の実験では、LDの不安定性・Ti:sapphireレーザの不安定性により、長時 間波長・スペクトルを安定に保つことができなかった。今後、外部共振器型LDは参照セルとロックイン アンプ等を用いた波長ロックシステムを構築する予定である。

参考文献

- [1] 長澤,阿保,"フラッシュランプ励起Ti:サファイアレーザの特性とライダーへの応用",第17回レー ザセンシングシンポジウム,No.A1 (1995)
- [2] H.Sato and J.Ohya,"Theory of Spectral Linewitdh of External Cavity Semiconductor Lasers", *IEEE J.Quant.Electron.* Vol.QE-22(7),1060-1063 (1986)
- [3] F.J.Duarte, Tunable Lasers Handbook, p. 349~442, Academic Press (1995)